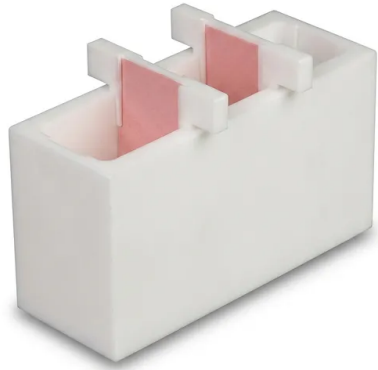


# 用于半导体与新能源研究中硅片处理及耐氢氟酸的方形Ptfе电化学池

货号: PL-CP151



## 简介

这款高纯度PTFE方形电化学池为半导体和新能源领域的硅片处理提供了卓越的耐氢氟酸性能，其尺寸完全可定制，并采用严格的定制化工程设计，以满足特定严苛的实验室研究和工业生产需求。

## 了解更多

应用	描述	主要优势
半导体晶圆蚀刻	用于使用基于HF的蚀刻剂从硅片上受控去除材料层。	零材料降解，精确容纳强腐蚀性酸液。
光伏研究	测试和优化硅基太阳能电池层和涂层的电化学反应效率。	在大尺寸方形基底上实现均匀的场分布。
锂离子电池测试	容纳腐蚀性电解质，用于分析新能源存储设备中阳极和阴极的性能。	对先进电池化学物质和电解质盐完全惰性。
纳米加工与MEMS	用于制造需要高纯度化学浴的机电系统的专用容器。	在关键加工步骤中防止痕量金属污染。
电镀工艺	在酸性或碱性浴中将金属沉积到半导体基底或能源相关组件上。	耐受极端pH值和高电流密度。
腐蚀科学	研究材料在高度侵蚀性环境（如化学加工中）中的耐久性。	可靠的容纳性能，在长期暴露中优于玻璃和标准聚合物。

规格	PL-CP151 详情
产品货号	PL-CP151
主要材料	高纯度PTFE（聚四氟乙烯）
槽体配置	方形/矩形整体槽
化学兼容性	氢氟酸、王水、硫酸、强碱、有机溶剂
基底兼容性	硅片（可定制为2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸或定制尺寸）
工作温度范围	-200°C 至 +260°C
定制选项	根据客户图纸定制尺寸、壁厚和端口位置
制造工艺	精密CNC加工（端到端）
密封组件	可选PFA/PTFE盖板、FKM/PTFE垫圈和PFA接头
内部光洁度	超光滑、低孔隙率表面，最大限度减少残留物积聚